技術論文

Diamond Like Carbon 膜の成膜因子と ラマン分光分析によるラマンパラメータの関係性

Relationship between Diamond-Like Carbon Film Deposition Factors and Raman Parameters by Raman Spectroscopy 土居 航介 村瀬 雄太 杉浦 敏昭

要旨

PIG (Penning Ionization Gauge) プラズマ CVD (Chemical Vapor Deposition) 方式^[1] による Diamond Like Carbon 成 膜装置にて、各種成膜因子を調整し、硬さの異なる 8 種類の膜を作成した。この膜について、膜硬さ、膜厚、ラマン分光分析、 ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) 分析、EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) 分析を行い、各種成膜因子と、 膜硬さ、膜厚、ラマンパラメータ、水素量、膜構造の相関性を確認した。ラマンパラメータは、基板電流値、膜硬さ、水素量、 sp³ 結合比と相関性があった。また EELS 分析値(膜構造解析)は、ラマンパラメータの D 半値幅、水素量と相関性があった。 ただし、硬さとは直接の相関性が見られなかった。これらの分析手法を用いて膜特性を最適化し、二輪車用エンジン部品へ 量産適用を行った。

Abstract

The various film deposition factors in a Diamond-Like Carbon deposition device utilizing the PIG (Penning Ionization Gauge) plasma CVD (Chemical Vapor Deposition) method^[1] were adjusted to create eight types of film with differing hardness. These films were analyzed for hardness, thickness, Raman spectroscopy, ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis), and EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) to confirm the relationship between the various deposition factors and hardness, thickness, Raman parameters, hydrogen content, and film structure. A relationship was found between Raman parameters and substrate current value, hardness, hydrogen content, and sp³ bonding ratio. In addition, a relationship was found between the EELS analysis value (structure analysis) and the Raman parameter D half-value width and the hydrogen content. However, no direct relationship with hardness was observed. Film characteristics were optimized using this analysis method and applied to mass production of motorcycle engine parts.

はじめに

Diamond Like Carbon 膜(以下、DLC 膜)は、低い摩 擦係数かつ高い耐摩耗性を有するため、自動車用エンジン の高回転・高出力化や燃費向上を目的に、動弁系やピスト ン周辺部品への量産適用が進んでいる^{[2][3]}。適用部品が拡 大するにつれて、DLC 膜の性能や耐久性が、コンポーネン トシステム全体の性能や耐久性を支配する要素となりつつあ る。よって、量産展開するにあたっては、その成膜因子と膜 特性の関係を十分理解し、膜特性を最適化すること、および 適切な品質管理手法を検討することが重要である。DLC 膜 は、sp²結合とsp³結合を含むアモルファス構造を持ち、そ の結合比によって膜特性が変化すること、また水素含有率に よってもその特性が変化することが報告されている^[4]。簡易 的に膜構造や水素量を計測する手法として、ラマン分光分 析による解析結果が報告されている^[5]。本稿では、DLC 膜 の成膜因子とその膜特性について、主にラマン分光分析に よるラマンパラメータに着眼して調査した結果を報告する。

2 試験方法

2-1. DLC 成膜装置

PIG(Penning Ionization Gauge) プラズマ CVD(Chemical Vapor Deposition)方式^[1]による成膜装置を用いた。図1 に装置の構成示す。本装置は、中間層としてマグネトロン スパッタ法によりメタル層を形成後、プラズマ CVD 法により DLC 膜を連続的に成膜する複合装置となっている。成膜室 (ϕ 600mm×高さ 660mm)上部にプラズマガンを配置し、 これに対向する位置にフローティング電位の反射電極を設け ている。カソードフィラメントから放出された熱電子は、プラ ズマガンと反射電極との間で往復振動を行い、ガスを効率 的にイオン化することができる。また、成膜室外周に一対の 電磁コイルを設けている。これにより、プラズマガンと反射 電極の間の軸方向に 1 ~ 10mT のミラー磁場を形成し、高 密度プラズマを形成することができる。基板には、緻密な皮 膜を得るために周波数 50 ~ 250kHz の非対称パルスバイ アス電圧を印加している。



図1 PIGプラズマCVD装置の構成^[1]

2-2. 試験片仕様

基板の形状は、板状で、幅 22mm、奥行き 26mm、厚 さ3.4mmとし、平面部を評価面とした。材質は、実部品を 模擬し、SCM420 にガス浸炭焼入れ・焼戻し後、評価面の 表面硬さが HRC60、浸炭深さが 0.7mm になるように、鏡 面研磨処理を施した。

2-3. 成膜条件

図1の基板セット位置に脱脂洗浄した試験片を固定し、 2×10³Paに減圧後、表1に示す条件にて前処理を行った。 前処理は、Ar イオンによるボンバード処理にて基材表面をク リーニング後、密着性を確保するためにマグネトロンスパッ タ法でTi 膜を形成した。

成膜条件を表2に示す。標準条件に対して、放電電流、 電磁コイル電流、成膜圧力、Ar ガス流量、H₂ ガス流量、 C₂H₂ ガス流量を変えて、I ~ VIIの組成の異なる DLC 膜を 試作した。

	ボンバード処理	Ti 膜処理
Ar ガス流量 mL/min	25	100
基板バイアス電圧 V	600	100
圧力 Pa	0.2	0.4
アノード電圧 V	50	50
放電電流 A	10	2
電磁コイル電流 A	5	5
カソード DC 電力 kW	-	4
処理時間 min	10	40

表1 前処理条件

	STD	Ι	П	Ш	IV	V	VI	VII
処理時間 min	45							
アノード電圧 V	50							
放電電流 A	30			2	30			
電磁コイル電流 A	14 5 20				14			
基板バイアス電圧 V	600							
圧力 Pa			1			2	1	L
Ar ガス流量 mL/min		50						10
H_2 ガス流量 mL/min	0					50	0	
C ₂ H ₂ ガス流量 mL/min	150 50 150					100	150	

2-4. 膜硬さ、膜厚

膜硬さは、ナノインデンテーション法により測定した。圧 子形状はビッカース圧子(四角錐)、試験荷重は 10mN、荷 重増加時間は 10sec とした。

膜厚は、同ロット処理の Si 基板にてマスキング法により測 定した。試験片表面に銀ペーストを1 滴塗布してマスクとし、 成膜後に脱脂洗浄により銀ペーストを除去後、接触式面粗 度計により膜厚段差を計測した。計測例を図2に示す。



図2 膜厚計測の例

2-5. ラマン分光分析

RENISHAW 製の顕微レーザーラマン分光装置を用いて測 定した。測定条件を表3に示す。得られた波形(図3)を、 1570cm⁻¹付近にピークを持つG(Graphite)バンド、およ び1400cm⁻¹付近にピークを持つD(Disorder)バンドに波 形分離を行い、それぞれの波形のピーク強度(Id,Ig)、ピー ク波数、半値幅を求めた。また、Gバンド位置のN/S比から、 Log(N/S)を求めた。

Gバンドは、鎖状、環状含め全ての sp² 炭素結合に由来 することが報告されており、Dバンドは、sp² 配位の構造の乱 れや欠陥に由来すること、六員環(グラファイトなど)の sp² 結合に由来することが報告されている^[5]。Log(N/S)は、 DLC 膜中の水素濃度と相関性があることが報告されてい る^[6]。

レーザー波長	532nm
レーザー形状	線形
露光時間	10 秒
積算回数	1 回
対物レンズ	20 倍
測定波数シフト域	$100 \sim 3200 {\rm cm}^{\cdot 1}$
波形分離関数	ガウス関数

表3 ラマン分光分析の測定条件



2-6. ERDA 分析

分析条件を表4に示す。ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis)分析は、試料の水素含有量を定量分析する 手法の一つであり、試料にイオンビームを照射し、反跳され た水素粒子 (H、H^{*})を半導体検出器により検出する手法で ある。また、水素濃度を明らかにするために、RBS(Rutherford Backscattering Spectrometry)分析により水素を除く元素 の成分を分析した。RBS分析は、ERDA分析と同様に試料 にイオンビームを照射し、試料後方にて弾性散乱によるエネ ルギー変化量を測定する手法である。

入射イオンのエネルギー	$2.3 \mathrm{MeV}$
イオン種	He ⁺⁺
# 利 <i>年</i>	ERDA:30°
IX 占L 円	RBS:160°
試料電流	25nA
照射量	20µC

表4 ERDA/RBS分析の測定条件

2-7. EELS 分析

分析条件を表5に示す。EELS(Electron Energy Loss Spectroscopy)分析は、試料に対して電子ビームを照射し、 入射した電子が試料内の電子を励起する際に失ったエネル ギーを測定することにより、試料の組成や元素の結合状態を 分析する手法である。本研究においては、反射電子を用い て EELS 分析を行った。また、sp² 結合、sp³ 結合、非晶質 成分をそれぞれグラファイト、ダイヤモンド、フラーレン(C₆₀) の測定結果を元に分離し、その比率を分析した。

表5 EELS分析の測定条件

分析装置	Perklin-Elmer 社製 PHI4300 走査型オージェ電子分光装置 Omicron 社製 EA125 静電半球型検出器
加速電圧	1.2kV
照射電流	40nA
ビーム径	φ8μm
分析面積	ビーム径に同じ
入射角	試料法線に対して 45°

3 試験結果と考察

各成膜条件にて成膜した DLC 膜の分析結果と、膜厚、膜 硬さ、成膜時の基板電流の値を表 6 に示す。基板電流は、 成膜時にワークおよびワークのホルダーに流れる電流であ る。一般的に、成膜速度が速いほど電流値も大きくなる傾向 があるため、成膜速度の目安となる。

次に、これらの値の相関性を確認するため、各項目の相 関係数を計算した(表 7)。このうち、強い相関性がある項 目の組み合わせ(相関係数の絶対値が 0.7 以上)について、 グラフを図 4 に示す。

本実験より、ラマンパラメータは、基板電流値・膜硬さ・ 水素量(ERDA分析値)・sp³結合比(EELS分析値)に対 して強い相関性が確認された。詳細に見ると、相関性が強 いパラメータは、基板電流値に対しては、Id/Ig・G中央波数・ G半値幅である。また、膜硬さに対しては、G半値幅、水素 量に対してはD中央波数、sp³結合比に対してはD半値幅 である。相関係数が正の場合は正の相関、負の場合は負の 相関を示す(図 5)。

			STD	I	I	Ш				
成膜条件	基板電流(A	s)	1.50	0.80	2.50	1.00				
	_ 膜厚 (um)		4.00	3.88	4.48	2.24				
	膜硬さ (GP	a)	21.2	18.0	15.6	23.0				
		ラマンスペクトル	counts	counts	counts	counts				
	ラマン分光注		Raman shift/cm ⁻¹	Raman shift/cm ⁻¹	Raman shift/cm ⁻¹	Raman shift/cm ⁻¹				
		Id/Ig	0.94	0.73	1.00	0.82				
分析結果		Dcenter (cm ⁻¹)	1402	1398	1405	1406				
		Gcenter (cm ⁻¹)	1570	1555	1579	1562				
		D半值唱 (cm-1)	344	350	356	350				
		G半値幅 (cm ⁻¹)	135	155	124	162				
		Log (N/S)at G pos.	-0.46	-0.45	-0.51	-0.47				
	RBS/ERDA	H含有量 (at%)	24.2	26.1	23.0	21.4				
		sp ³ (%)	22.7	21.4	17.1	18.9				
	FELS	sp ² (%)	22.2	14.7	24.9	30.2				
		C ₆₀ (%)	55.1	63.9	58.0	50.9				
		$sp^{2}/(sp^{2}+sp^{3})$	0.49	0.41	0.59	0.62				
	1									
			TV/	V	\Л	νπ				
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	 ↓其板雷流(Δ		IV 1 50	V 1.60	VI 1.90	VII 1.80				
成膜条件	基板電流(A 	x)	IV 1.50 2.67	V 1.60 3.97	VI 1.90	VII 1.80 4.50				
成膜条件	基板電流(A 膜厚 (um) 膜硬さ (GP	() () ()	IV 1.50 2.67 16.9	V 1.60 3.97 15.5	VI 1.90 3.44 17.4	VII 1.80 4.50 15.7				
成膜条件	基板電流(A 膜厚 (um) 膜硬さ (GP	() () ラマンスペクトル	IV 1.50 2.67 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9	V 1.60 3.97 15.5 **********************************	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4	VII 1.80 4.50 15.7 state Raman shift/cm ³				
成膜条件	基板電流(A 膜厚 (um) 膜硬さ (GP) (a) ラマンスペクトル [d/lg	<u>N</u> 1.50 2.67 16.9 2.67 16.9 2.67 16.9 2.67 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.67 16.9	V 1.60 3.97 15.5 28 * * Raman shift/cm ⁻¹ 0.96	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 Set Raman shift/cm ¹ 1.04	VII 1.80 4.50 15.7 58 8 15.7 15.7 15.7 15.7 0.93				
成膜条件	基板電流(A 膜厚 (um) 膜硬さ (GP	a) ラマンスペクトル Id/Ig Doenter (cm ⁻¹)	N 1.50 2.67 16.9 gradient * Raman shift/cm ¹ 1.00 1403	V 1.60 3.97 15.5 9 * Raman shift/cm ¹ 0.96 1402	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 1.04 1.04 1.04	VII 1.80 4.50 15.7 generations Raman shift/cm ³ 0.93 1399				
成膜条件	基板電流(A 腹厚 (um) 腹硬さ (GP	a) ラマンスペクトル Id/Ig Dcenter (cm ¹) Gcenter (cm ¹)	N 1.50 2.67 16.9 """"""""""""""""""""""""""""""""""""	V 1.60 3.97 15.5 * Raman shift/cm ⁻¹ 0.96 1402 1572	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 17.4 17.4 1.04 1.04 1.04 1403 1576	VII 1.80 4.50 15.7 25 8 4.50 15.7 0.93 1399 1575				
成膜条件	基板電流(A 膜厚 (um) 膜硬さ (GP) Pa) ラマンスペクトル Id/Ig Dcenter (cm ⁻¹) Gcenter (cm ⁻¹)	IV 1.50 2.67 16.9 16.9 16.9 1.00 1.00 1.00 1403 1573 350	V 1.60 3.97 15.5 * Raman shift/cm ¹ 0.96 1402 1572 346	VI 1.90 3.44 17.4 ************************************	VII 1.80 4.50 15.7 state * Raman shift/cm ³ 0.93 1399 1575 344				
成膜条件	基板電流(A 膜厚 (um) 膜硬さ (GP	a) Pa) Dcenter (cm ⁻¹) Gcenter (cm ⁻¹) G半値幅 (cm ⁻¹)	N 1.50 2.67 16.9 * Raman shift/cm ¹ 1.00 1403 1573 350 130	V 1.60 3.97 15.5	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 1.04 1403 1576 354 126	VII 1.80 4.50 15.7 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 15.7				
成膜条件	基板電流(A 腹厚 (um) 腹硬さ (GP ラマン分光法) a) 「マンスペクトル Id/Ig Dcenter (cm ¹) Gcenter (cm ¹) の半値幅 (cm ⁻¹) G半値幅 (cm ⁻¹) Log (NS)at G pos	$\begin{array}{c c} \hline N \\ \hline 1.50 \\ 2.67 \\ \hline 16.9 \\ \hline \\ 9 \\ \hline \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $	V 1.60 3.97 15.5	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 1.04 1.04 1403 1576 354 126 -0.45	VII 1.80 4.50 15.7				
成膜条件	基板電流(A 腹厚 (um) 腹硬さ (GP ラマン分光法 RBS/ERDA	id/lg Dcenter (cm ¹) の半値幅 (cm ⁻¹) G半値幅 (cm ⁻¹) の半値幅 (cm ⁻¹) にの (N/S)at G pos. 日含有量 (at%)	N 1.50 2.67 16.9 state state no 1403 1573 350 130 -0.44 22.2	V 1.60 3.97 15.5 3.97 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 15.5 3.46 14.02 15.5 3.46 14.02 15.5 3.46 14.02 15.5 3.46 14.02 15.5 3.46 13.2 -0.52 24.1 1.52 1	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05 0.354 126 -0.45 22.9	VII 1.80 4.50 15.7 15.7 Raman shift/cm ³ 0.93 1399 1575 344 120 -0.38 25.2				
<u>成膜条件</u> 分析結果	基板電流(A 腹厚 (um) 膜硬さ (GP ラマン分光法 RBS/ERDA	a) Pa) Id/Ig Dcenter (cm ¹) Gcenter (cm ¹) G半値幅 (cm ⁻¹) G半値幅 (cm ⁻¹) Log (NS)a G pos. H含有量 (at%) sp ³ (%)	Image: Non-state state s	V 1.60 3.97 15.5 * Raman shift/cm ¹ 0.96 1402 1572 346 132 -0.52 24.1 23.3	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 1.04 1403 1576 354 126 -0.45 22.9 18.9 1576	VII 1.80 4.50 15.7 Raman shift/cm ¹ 0.93 1399 1575 344 120 -0.38 25.2 20.6				
<u>成膜条件</u> 分析結果	基板電流(A 膜厚 (um) 膜硬さ (GP ラマン分光法 RBS/ERDA EELS	i) Pa) Dcenter (cm ⁻¹) Gcenter (cm ⁻¹) G平値幅 (cm ⁻¹) G平値幅 (cm ⁻¹) 日孝有値 (at%) sp ³ (%) sp ² (%)	$\begin{tabular}{ c c c c c } \hline V \\\hline 1.50 \\\hline 2.67 \\\hline 16.9 \\\hline 16.9 \\\hline 16.9 \\\hline 16.9 \\\hline 16.9 \\\hline 16.9 \\\hline 1.00 \hline\hline 1.00 \\\hline 1.00 \hline\hline 1.00 \\\hline 1.00 \hline\hline 1.00 \\\hline 1.00 \hline\hline $1.00$$	V 1.60 3.97 15.5 5 5 7 8 8 8 15.5 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 24.1 23.3 24.3 15.7 15.	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 10.4 1403 1576 354 126 -0.45 22.9 18.9 28.7	VII 1.80 4.50 15.7 15.7 Raman shift/cm ³ 0.93 1399 1575 344 120 -0.38 25.2 20.6 31.6				
成膜条件	基板電流(A 膜厚 (um) 膜硬さ (GP ラマン分光法 RBS/ERDA EELS	i) Pa) Dcenter (cm ⁻¹) Gcenter (cm ⁻¹) G半値幅 (cm ⁻¹) G半値幅 (cm ⁻¹) Log (NS)at G pos. H含有量 (at%) sp ² (%) Sp ² (%) Ceo (%)	N 1.50 2.67 16.9 2 3 1.00 1403 1573 350 130 -0.44 22.2 17.1 25.9 57.0	V 1.60 3.97 15.5	VI 1.90 3.44 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 10.4 1403 1576 354 126 -0.45 22.9 18.9 28.7 52.4	$VII 1.80 4.50 15.7 g_{e}^{*}Raman shift/cm30.9313991575344120-0.3825.220.631.647.8$				

耒6	分析結里-	-暫夫
101	刀仰而木	-見衣

表7	各パラメー	-タの相関係数-	-覧表
----	-------	----------	-----

	膜厚 (um)	膜硬さ (GPa)	ラマン Id/Ig	ラマン Dcenter (cm ⁻¹)	ラマン Gcenter (cm ⁻¹)	ラマン D半値幅 (cm ⁻¹)	ラマン G半値幅 (cm ⁻¹)	ラマン Log(N/S) at G pos.	ERDA 水素量 at%	EELS sp ³ %	EELS sp ² %	EELS C ₆₀ (%)	EELS sp ² / (sp ² +sp ³)
基板電流 (A)	0.52	-0.59	0.82 ※⊠4-1	0.32	0.93 ※⊠4-2	0.40	-0.85 ※⊠4-3	-0.18	-0.18	-0.37	0.39	-0.24	0.51
膜厚 (um)		-0.60	0.14	-0.52	0.37	-0.17	-0.58	-0.02	0.71 ※図4-4	-0.37	-0.23	0.07	-0.32
膜硬さ (GPa)			-0.45	0.31	-0.55	-0.19	0.73 ※図4-5	0.01	-0.36	0.09	0.01	-0.05	-0.05
ラマン Id/Ig				0.47	0.94 ※⊠4-6	0.26	-0.83 ※図4-7	-0.13	-0.41	-0.41	0.49	-0.37	0.60
ラマン Dcenter (cm ⁻¹)					0.33	0.50	0.04	-0.51	-0.95 ※図4-8	-0.52	0.45	-0.24	0.62
ラマン Gcenter (cm ⁻¹)						0.18	-0.92 ※図4-9	-0.02	-0.26	-0.31	0.56	-0.45	0.63
ラマン D半値幅 (cm ⁻¹)							-0.03	-0.37	-0.46	-0.77 ※⊠4-10	0.01	0.35	0.32
ラマン G半値幅 (cm ⁻¹)								-0.15	-0.10	0.14	-0.35	0.31	-0.38
ラマン Log(N/S)at G pos.									0.26	-0.11	0.35	-0.32	0.24
ERDA 水素量 at%										0.63	-0.57	0.30	-0.73 ※図4-11
EELS sp ³ %											-0.37	-0.09	
EELS sp ² %												-0.90 ※⊠4-12	



図4 相関係数が大きいもの



図5 ラマンパラメータ 相関図

また、EELS 分析(膜構造解析)値については、上述の 通りラマンパラメータ(D 中央波数)に加え、sp²/(sp²+sp³) も水素量に対して強い相関性が確認された。ただし、膜硬さ とは直接の相関性が見られなかった。

sp³ 結合比と D 半値幅の相関性については、一般的な事 象として報告されておらず、本実験において明らかとなった。 ラマンスペクトルの D バンドは、前述の通り sp² 結合の構造 の欠陥や六因環構造に由来するものであり^[4]、D 半値幅の 減少は構造の均一性(結晶性)を意味する。本実験により 得られたデータは、sp³ と sp² の結合比が相互の結合状態や 結晶性に関係していることを示唆するものである。

また、一般的に sp³ 結合比が増加すると DLC 膜はダイヤ モンドに近い結晶構造になり、逆に sp² 結合比が増加すると グラファイトに近い結晶構造になることが知られている。よっ て、EELS 分析による sp²と sp³ 結合比の分析値は、膜硬さ との直接的な相関があると予想されたが、本実験において は相関性が低い結果となった。この理由として、各成膜品の 結合比の分析結果は、50% 以上が非晶質成分であることか ら、膜硬さに対しては非晶質成分の構造が支配的になった ためと推定した。

また、一般的に水素量が増加すると、炭素の充填率が減 少するため、膜硬さは減少する傾向にあることが知られてい る。しかし本実験においては、膜硬さと水素量の相関性は 低い結果となった。この理由として、各成膜品の ERDA 分析 による水素量の分析値が 21.4 ~ 26.1% に分布しており、大 差が無いことが影響したと考えられる。本実験は CVD 法によ る DLC 膜のみ分析していることから、例えば水素含有量の 少ない PVD (Physical Vapor Deposition) 法により成膜し た DLC 膜もあわせて分析すれば、相関性が確認できると考 えられる。

4 おわりに

DLC 膜の成膜因子とその膜特性について、主にラマン分 光分析によるラマンパラメータに着眼して調査した結果、以 下の知見を得た。

- ラマンパラメータは、基板電流値、膜硬さ、水素量、 sp³ 結合比と相関性があった。
- 2) EELS 分析値(膜構造解析)は、ラマンパラメー タの D 半値幅、水素量と相関性があった。ただし、 膜硬さとは直接の相関性が見られなかった。

これらの分析手法を用いて膜特性を最適化し、オフロード 用モトクロッサー(図 6)のピストンピン外周部(図 7)へ 生産適用した。

本技術は、2016年から累計で5万本以上、内製による 生産実績をあげており、商品魅力向上に寄与している。



図6 オフロード用モトクロッサー

■参考文献

[1]寺山暢之,"PIGプラズマCVD法によるDLCコーティング技術",J. Plasma Fusion Res.Vol87, No.8 (2011) P548-555
[2]馬渕豊,"DLC膜の自動車部品への適用",トライボロジスト第58巻第8号(2013) P557-565
[3]土居航介,"チタン製動弁系部品へのDLC膜適用と密着性評価",トライボロジー会議予稿集9(2012) P423
[4]A. C. Ferrari and J. Robertson, "Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon", PHYSICAL REVIEW B Vol.61(20) (2000) P14 095
[5]長田実ら,"ラマン分光法による炭素材料の評価",TANSO 2007 No.228 P174-184
[6]三浦健一,"ラマン分光法によるDLC膜中の水素濃度分析",TRI Technical Sheet No.08003(2008)

■著者



土居 航介 Kosuke Doi パワートレインユニット コンポーネント統括部 材料技術部



村瀬 雄太 Yuta Murase パワートレインユニット コンポーネント統括部 材料技術部



杉浦 敏昭 Toshiaki Sugiura パワートレインユニット コンポーネント統括部 材料技術部



図7 DLC処理されたピストンピン